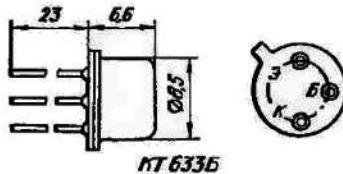


КТ633Б

Кремниевый эпитаксиально-планарный переключа-
тельный транзистор *n-p-n*. Предназначен для работы в высокочастотных и импульсных устройствах радиоэлектронной аппаратуры.

Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.

Эксплуатируется при $\theta_{\text{опр}}$ от -45 до $+85$ °С.
Масса транзистора не более 3 г.



Электрические параметры и предельные значения допустимых режимов работы

| Обозначение | Режим измерения | Значения |
|--|--|------------------------|
| $f_{21\text{дБ}}$ $f_{\text{гр}}$, МГц | $U_{\text{КБ}}=1$ В; $I_{\text{Э}}=10$ мА $U_{\text{КЭ}}=10$ В; $I_{\text{К}}=10$ мА; $f=$ $=1000$ МГц | 20...160 ≥ 300 |
| $I_{\text{КБ0}}$, мкА | $U_{\text{КБ}}=30$ В | ≤ 10 |
| $I_{\text{ЭБ0}}$, мкА | $U_{\text{ЭБ}}=4,5$ В | ≤ 10 |
| $U_{\text{КЭ макс}}$, В | $I_{\text{К}}=100$ мА; $I_{\text{Б}}=10$ мА | $\leq 0,6$ |
| $C_{\text{к}}$, пФ | $U_{\text{КБ}}=10$ В; $I_{\text{Э}}=0$; $f=10$ МГц | $\leq 5,5$ |
| $C_{\text{э}}$, пФ | $U_{\text{ЭБ}}=0,5$ В; $I_{\text{К}}=0$; $f=10$ МГц | ≤ 30 |
| $t_{\text{рас}}$, нс | $I_{\text{К}}=10$ мА; $I_{\text{Б1}}=I_{\text{Б2}}=10$ мА | ≤ 30 |
| $U_{\text{КБ макс}}$, В | -45 °С $\leq \theta_{\text{опр}} \leq 85$ °С | 30 |
| $U_{\text{ЭБ макс}}$, В | -45 °С $\leq \theta_{\text{опр}} \leq 85$ °С | 4,5 |
| $I_{\text{К макс}}$, мА | -45 °С $\leq \theta_{\text{опр}} \leq 85$ °С | 200 |
| $I_{\text{К и макс}}$, мА | То же, при $t_{\text{и}} \leq 10$ мкс; $Q \geq 50$ | 500 |
| $P_{\text{К макс}}$, мВт | -45 °С $\leq \theta_{\text{опр}} \leq 25$ °С | 360 |
| $P_{\text{К и макс}}$, мВт | То же, при $\tau_{\text{и}} \leq 10$ мкс; $Q \geq 50$ | 720 |
| $\theta_{\text{пер макс}}$, °С | — | 150 |

¹ В интервале температур от 25 до 85 °С мощность (В:) рассчитывается по формуле $P_{\text{К макс}}=(150-\theta_{\text{опр}})/347,22$.